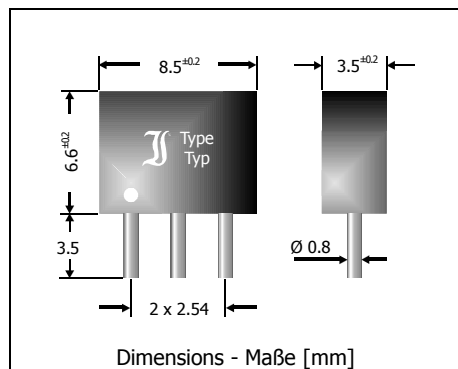
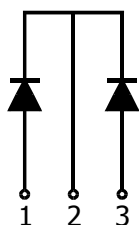


DAN208 / DAP208 (1.2 W)
Silicon-Twin Rectifiers – Center Tap
Silizium-Doppeldiode – Mittelpunktschaltung

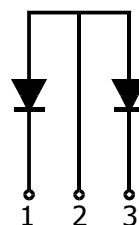
Version 2008-04-15



Nominal power dissipation 1.2 W
 Nenn-Verlustleistung
 Repetitive peak reverse voltage 150 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 3-pin Plastic case 8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
 3-Pin Kunststoffgehäuse
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.7 g
 Standard packaging bulk
 Standard Lieferform lose im Karton



"DAN" common cathodes / gemeinsame Kathoden



"DAP" common anodes / gemeinsame Anoden

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] ¹⁾
DAN208	100	150
DAP208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	$1\text{ A}^{2)}$ $2\text{ A}^{2)}$
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	$1\text{ A}^{2)}$ $2\text{ A}^{2)}$
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	10/11 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	$-50...+150^\circ\text{C}$ $-50...+150^\circ\text{C}$

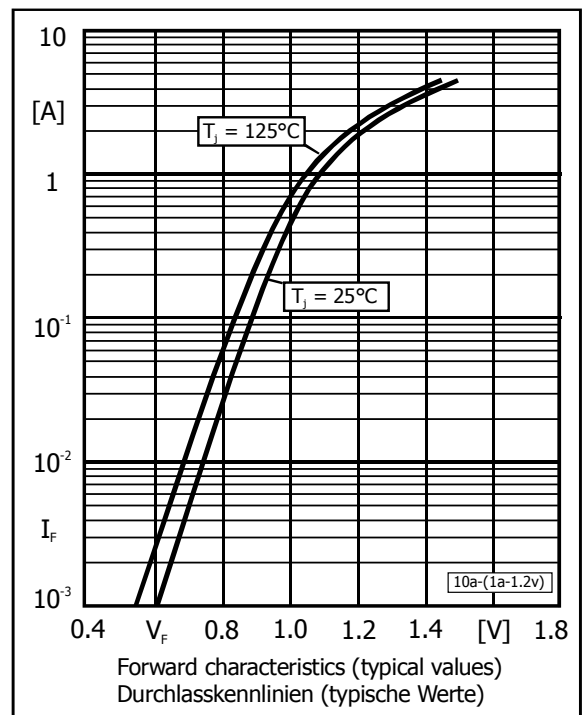
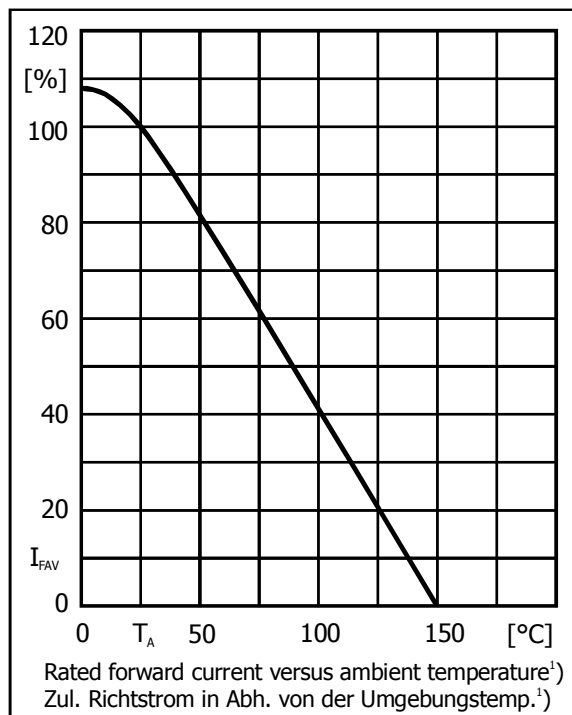
1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.2\text{ V}^1)$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 100\text{ V}$	I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	$< 45\text{ K/W}^2)$



1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden